



SiC气相外延装置

专利名称: SiC气相外延装置
专利类别: 实用新型
申请号: 202021178328X
第一发明人: 陈蛟
其它发明人: 杨军伟;宋华平;简基康;王文军;陈小龙
专利授权日期: 2021-03-02

[关闭窗口](#)

